【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年11月24日(2011.11.24)

【公開番号】特開2010-56583(P2010-56583A)
【公開日】平成22年3月11日(2010.3.11)
【年通号数】公開・登録公報2010-010
【出願番号】特願2009-280852(P2009-280852)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｓ　5/22　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｓ　5/22

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月4日(2011.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１半導体層上に形成された活性層と、
前記活性層上に形成され、凸部と、前記凸部以外の平坦部とを有する第２半導体層と、
前記第２半導体層上に形成された電流ブロック層と、
前記凸部上に形成された第１電極層と、
前記第１電極層上および前記電流ブロック層上に形成された第２電極層とを備え、
前記第１電極層は、共振器端面近傍の領域まで延びて形成されており、
前記第２電極層の前記共振器端面側の端部は、前記共振器端面近傍の領域から所定の間隔を隔てて配置されている、半導体レーザ素子。
【請求項２】
前記電流ブロック層は、前記第２半導体層の前記共振器端面側の端部にまで形成されている、請求項１に記載の半導体レーザ素子。
【請求項３】
前記平坦部の前記共振器端面近傍かつ前記凸部近傍の領域には、凹部が形成されている、請求項１または２に記載の半導体レーザ素子。